

Обратный ток эмиттера □:

при температуре 20°С	не более 1 ма
» » 70°С	не более 2 ма

Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером □:

при токе коллектора 0,5 а [⊕]	20—60
» » » 1,5 а [▲]	не менее 20

Напряжение переноса фазы базового тока ∇ не менее 35 а

Напряжение насыщения °:

коллектор—эмиттер	не более 2 а
база—эмиттер ■	не более 1,2 а

Время расщепления ∇ не более 3 мксек

Время включения ∇ не более 0,3 мксек

Постоянная времени цепи обратной связи[⊙] не более 500 нсек

Емкость перехода:

коллекторного [⊕]	не более 130 пф
эмиттерного ^{**}	не более 2000 пф

Долговечность не менее 10 000 ч

* При напряжении коллектора минус 40 а и сопротивлении в цепи база—эмиттер 100 ом.

○ При напряжении коллектора минус 45 а.

▲ При напряжении коллектора минус 40 а.

□ При напряжении эмиттера минус 1 а.

⊕ В режиме базового сигнала, при длительности импульсов 5 мксек и частоте 1—10 кГц.

∇ При напряжении коллектор—эмиттер минус 3 а.

▲ При напряжении коллектор—эмиттер минус 7 а.

∇ При токе эмиттера 0,3 а, длительности импульсов 5 мксек и частоте 1—10 кГц.

° При токе базы 60 ма и степени насыщения 2—5.

■ При токе коллектора 0,5 а.

∇ В схеме с общим эмиттером при токе коллектора 0,5 а, токе базы 60 ма, длительности импульсов 5—10 мксек и частоте 1—10 кГц.

⊙ При напряжении коллектора минус 20 а и частоте 5 МГц.

⊕ При токе эмиттера 50 ма.

** При напряжении эмиттера минус 0,5 а и частоте 5 МГц.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшее напряжение коллектор—база минус 45 а

Наибольшее напряжение коллектор—эмиттер:

при температуре 20°С [*]	минус 40 а
» » 70°С [▲]	минус 20 а

закрытого транзистора минус 45 а

Наибольшее обратное напряжение эмиттер—база при температуре 20, 70 и минус 60°С 1 а

Наибольшая амплитуда импульса тока коллектора при температуре 20, 70 и минус 60°С 1,5 а

Наибольшая амплитуда импульса тока базы при температуре 20, 70 и минус 60°С 0,5 а

ГЕРМАНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР
р-п-р

П605

Наибольшая рассеиваемая мощность без теплоотво-	
да:	
при температуре от минус 60 до плюс 60°С □ .	0,5 <i>вт</i>
» » 70°С	0,3 <i>вт</i>
Наибольшая рассеиваемая мощность с теплоотво-	
дом:	
при температуре от минус 60 до плюс 25°С □ .	3 <i>вт</i>
» » 70°С	0,75 <i>вт</i>
Тепловое сопротивление:	
переход—корпус	15 <i>град/вт</i>
Тепловое сопротивление корпус—окружающая сре-	
да:	
без теплоотвода	35 <i>град/вт</i>
с теплоотводом ○	5 <i>град/вт</i>
Наибольшая температура перехода	плюс 85°С

* При сопротивлении в цепи база—эмиттер 100 ом.

△ При сопротивлении в цепи база—эмиттер 10 ом.

□ Наибольшая мощность, рассеиваемая транзистором с теплоотводом при температуре окружающей среды свыше 25°С и без теплоотвода при температуре свыше 40°С, определяется по формуле

$$P_{C \text{ MAX}} = \frac{85 - t_{\text{amb}}}{15 + R_{\text{thca}}} \text{ (вт)},$$

где R_{thca} — тепловое сопротивление корпус—окружающая среда.
При отсутствии теплоотвода $R_{\text{thca}} = 35 \text{ град/вт}$.

○ Для алюминиевого теплоотвода площадью 30 см² и толщиной 1,5 мм

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Температура окружающей среды:	
наибольшая	плюс 70°С
наименьшая	минус 60°С
Наибольшая относительная влажность при темпера-	
туре 40°С	98%
Давление окружающей среды:	
наибольшее	3 <i>ат</i>
наименьшее	5 мм рт. ст.
Наибольшее ускорение:	
при вибрации*	15 <i>г</i>
линейное	150 <i>г</i>
при многократных ударах	150 <i>г</i>
при одиночных ударах	500 <i>г</i>

* В диапазоне частот 2—2500 *гц*.

П605
П605А
П606

ГЕРМАНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
р-п-р

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 3 мм от корпуса.

При эксплуатации транзистор необходимо жестко закрепить на шасси с помощью навесного фланца.

При необходимости электрической изоляции корпуса (коллектора) транзистора от шасси или теплоотвода с помощью прокладок следует иметь в виду, что суммарное тепловое сопротивление между переходом и теплоотводом увеличивается.

Гарантийный срок хранения 12 лет*

* При хранении транзисторов в складских условиях в упаковке поставщика, в ЗИПе, а также смонтированными в аппаратуру.

В течение гарантийного срока допускается хранение изделий в полевых условиях:

- а) в составе аппаратуры и ЗИП, защищенных от непосредственного воздействия солнечной радиации и влаги, — 3 года;
- б) в составе герметизированной аппаратуры и ЗИП в герметизированной упаковке — 6 лет.

П605А

Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при токе коллектора 0,5 а	50—120
Время рассасывания*	не более 4 мксек
Время включения*	не более 0,35 мксек
Напряжение насыщения*:	
коллектор—эмиттер	не более 2 в
эмиттер—база	не более 1,2 в

* При токе базы 30 ма.

Примечание. Остальные данные такие же, как у П605.

П606

Начальный ток коллектора*	не более 3 ма
Обратный ток коллектора:	
при температуре 20° С Δ	не более 2 ма
» » 70° С \square	не более 8 ма
Обратный ток эмиттера \square :	
при температуре 20° С	не более 1 ма
» » 70° С	не более 2 ма
Модуль коэффициента передачи тока на частоте 10 Мгц \square	не менее 3
Напряжение переворота фазы базового тока \square \square	не менее 20 в
Наибольшее напряжение коллектор—база	минус 35 в

ГЕРМАНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

p-n-p

**П606
П606А**

Наибольшее напряжение коллектор—эмиттер:

при температуре 20° С минус 25 в

» » 70° С минус 15 в

закрытого транзистора минус 35 в

Наибольшее обратное напряжение эмиттер—база

при температуре 20, 70 и минус 60° С 0,5 в

* При напряжении коллектора минус 25 в.

△ При напряжении коллектора минус 35 в.

□ При напряжении коллектора минус 30 в.

○ При напряжении эмиттера минус 0,5 в.

⊖ При напряжении коллектора минус 10 в, и токе эмиттера 0,05 а.

⊞ При напряжении коллектора минус 20 в.

Примечание. Остальные данные такие же, как у П605.

П606А

Начальный ток коллектора* не более 3 ма

Обратный ток коллектора:

при температуре 20° С △ не более 2 ма

» » 70° С □ не более 8 ма

Обратный ток эмиттера ○:

при температуре 20° С не более 1 ма

» » 70° С не более 2 ма

Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при токе коллектора 0,5 а 50—120

10 МГц Модуль коэффициента передачи тока на частоте не менее 3

Напряжение переворота фазы базового тока^{1,2} не менее 20 в

Время рассасывания* не более 4 мксек

Время включения² не более 0,35 мксек

Напряжение насыщения²:

коллектор—эмиттер 2 в

база—эмиттер 1,2 в

Наибольшее напряжение коллектор—база минус 35 в

Наибольшее напряжение коллектор—эмиттер:

при температуре 20° С минус 25 в

» » 70° С минус 15 в

закрытого транзистора минус 35 в

1 при Наибольшее обратное напряжение эмиттер—база 0,5 в

* При напряжении коллектора минус 25 в.

△ При напряжении коллектора минус 35 в.

□ При напряжении коллектора минус 30 в.

○ При напряжении эмиттера минус 0,5 в.

⊖ При напряжении коллектора минус 10 в, и токе эмиттера 0,05 а.

⊞ При напряжении коллектора минус 20 в.

⊞ При токе базы 30 ма.

Примечание. Остальные данные такие же, как у П605.